



Technique

Dépôt physique en phase vapeur

Caractéristiques-performances :

Energie du faisceau : 100 eV à 1200 eV
 Pression de base 5.10^{-7} mb
 Température du substrat : 25°C à 700°C
 Porte cible 4 positions (changement manuel)

Principales caractéristiques

Faisceau / cibles

Source Kaufman, ϕ 7,5 cm, filaments tantale, grilles carbone
 Tension d'accélération : 100 à 1200 V
 Courant ionique 60 mA
 Cibles disponibles : Au, C, Fe, Ni, Sb, Si, W, SiC, TiC
 Pression de base 5.10^{-7} mb, pompe turbo moléculaire

Portes échantillons

Tournant refroidi par eau
 Four tournant 700°C
 Dépôt sur échantillons cylindriques
 Possibilité de dépôt sur substrats pré-contraints
 Température variable pour irradiation / implantation ionique basse énergie

Applications typiques :

Etude des propriétés mécaniques de :

Films nano-cristallins sur substrats souples
 Films nano-cristallins sur substrats pré-contraints
 Films texturés

Personne à contacter : Michel Drouet